



SI7102DN-T1-GE3

Fabricant Numéro d'article:	SI7102DN-T1-GE3
Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Partie de la description:	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
Feuilles de données:	SI7102DN-T1-GE3.pdf
État sans plomb / État RoHS:	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 25500 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

SI7102DN-T1-GE3 100% Nouveaux originaux 25500 en stock, Trouver SI7102DN-T1-GE3 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez SI7102DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ SI7102DN-T1-GE3: Info@IC-Components.com



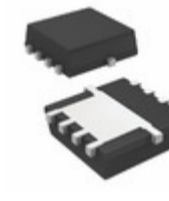


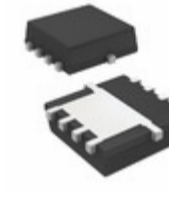



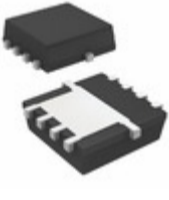




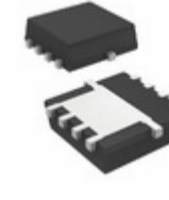

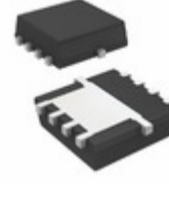

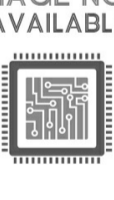






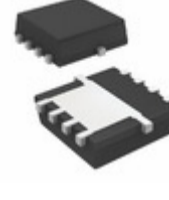

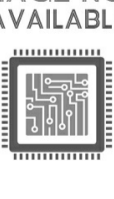

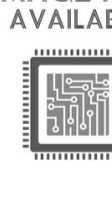
Les spécifications de SI7102DN-T1-GE3

Numéro d'article	SI7102DN-T1-GE3	Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Séries	TrenchFET®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	PowerPAK® 1212-8	Emballage	Cut Tape (CT)
Type de montage	Surface Mount	Package composant fournisseur	PowerPAK® 1212-8
Température de fonctionnement	-50°C ~ 150°C (TJ)	Description détaillée	N-Channel 12V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface Mount PowerPAK® 1212-8
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Dissipation de puissance (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
type de FET	N-Channel	Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	12V	Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V	Vgs (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Charge de la porte (Cg) (Max) @ Vgs	110nC @ 8V	Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	3720pF @ 6V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	2.5V, 4.5V	Vgs (Max)	±8V
Autres noms	SI7102DN-T1-GE3CT	Quantité en stock	25500 pcs Stock
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - Single	La description	MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à SI7102DN-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Partie SI7102DN-T1-GE3	Prix SI7102DN-T1-GE3	Distributeur SI7102DN-T1-GE3
SI7102DN-T1-GE3 technique	Action SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3 Inventaire	SI7102DN-T1-GE3 Fournisseur
Commande en ligne SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3 Enquête	Image SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3 Image
SI7102DN-T1-GE3 pdf	Fiche technique SI7102DN-T1-GE3	Fiche technique SI7102DN-T1-GE3	SI7102DN-T1-GE3 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique SI7102DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7102DN-T1-GE3
Vishay Electro-Films SI7102DN-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SI7102DN-T1-GE3		

Vous pouvez également être intéressé par:

 <p>SI7108DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 69500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7113DN-T1-E3 La description: MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 9500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7104DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 25500 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7112DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 14200 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7102DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7110DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 40600 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7100DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 25500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7107DN-T1-E3 La description: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 La description: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1700 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7100DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7108DN-T1-E3 La description: SI7108DN-T1-E3 VISHAY POWERPAK1 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 4900 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7100DN La description: SI7100DN SI QFN-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7021-A10-GM1R La description: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs) En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7020-A10-GM1R La description: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 3% DFN Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7107DN-T1-GE3 La description: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7110DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 72000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7013-A10-GM1R La description: SENSOR HUM/TEMP 3.6V I2C 2% DFN Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7106 La description: SI7106 DFN33-8 14 Fabricants: DFN33-8 En stock: Nouvel original, stock 6000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7104DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1500 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7106DN-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 25500 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7108DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 27400 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7020-A20-IM1R La description: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs) En stock: Nouvel original, stock 2000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7112DN-T1 La description: SI7112DN-T1 VISHAY QFN-8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7106DN La description: SI7106DN VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7112DN-T1-E3 La description: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7020-A10-GM La description: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs) En stock: Nouvel original, stock 200 disponible. Citation: RFQ</p>
 <p>SI7113DN La description: SI7113DN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 100 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7106JN-T1-GE3 La description: SI7106JN-T1-GE3 VISHAY DFN-833 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 21000 disponible. Citation: RFQ</p>	 <p>SI7108DN La description: SI7108DN SI QFN1212-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible. Citation: RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong